シリカガラスと水

産業技術総合研究所 近接場光応用工学研究センター

粟津浩一

Water in silica glass

Koichi Awazu

Center for Applied Near – Field Optics Research (CAN – FOR) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

1.はじめに

特集

ガラス中の水に関しては, 古くより多くの研 究がなされている。それは、ガラス中の水は、 熱膨張係数の上昇や粘性の減少、屈折率、密度 といった古くより今日に至るまでガラスの製 造,利用において重要な特性に大きく影響する ためであった。シリカガラスにおいて水が大問 題となったのは、1982 年 6 月に電電公社によ り実施された光ファイバー敷設路線の安定度試 験の結果を巡ってであった。¹⁾敷設後2年を経 過した光ファイバーの一部で, 従来全く予測し ていなかった長波長帯域における光伝送損失増 加現象が報告された。さらに、水を注入したま ま数ヶ月放置した光ケーブルにおいても新たな 損失現象が観察された。これらの損失現象は, 光通信の実用化を進める上で大きな障害となる ことからその原因究明と対策について、諸研究 機関にて広範な研究が精力的に進められてき

〒305-8562 つくば市東 1-1-1 (併) 東京大学工学系研究科産業機械工学専攻 E-mail:k.awazu@aist.go.jp た。その結果原因は、まず1.3 ミクロン付近に 現れる OH 基による光吸収帯であることが明ら かとなった。当初は、線引きのし易さを考え て、P₂O₅ を添加していたが、これをやめるこ とによって著しく改善が見られた。もう一つ は、水素分子とシリカガラスネットワークが水 素結合したことによる光伝送損失である。すな わち伝送波長領域に15 もの吸収ピークが確認 された。これらは、全てジャケット管から発生 した水素でありジャケット管を改良することに より、問題は解決した。

1985 年ごろより,半導体リソグラフィーの 光源として,エキシマレーザーの利用が視野に 入ってきた。ところが,当時のシリカガラスで は耐性が悪かったため,複数の産学連携による 研究が活発に行われた。光ファイバーでは悪玉 であった水素と OH 基が今度は逆に,レーザー 耐性に向上つながることが明らかになり,今日 のエキシマレーザーリソグラフィーを可能とし た。

これらの事例は,(シリカ)ガラスの水は, ある用途においては negative な効果をもたら すが,また別の目的においては有効であるとい

16

http://staff.aist.go.jp/k.awazu

http://www.nanome.t.u-tokyo.ac.jp/index.html

うことを意味している。これまでにも OH 基を 化学反応プロセスに用いる多くの研究が報告さ れてきた。特に表面化学の分野において重要 で、OH 基を介した表面修飾は化学の分野おい て、今も多くの研究がなされている。クロマト グラフィーにおける担持物質の修飾、機能性物 質の担持などである。そこで、本稿では紙面の 制約上、シリカガラスに絞って、その帰属や評 価方法についてまとめてみた。

2. ガラス中の OH 基の検出

シリカガラス中の水の同定,定量に関して は、赤外吸収分光やラマン散乱分光が有効であ り、既に多くの論文が発表されている。また, 湿式分析でカールフィシャー法があり,ppm オーダーでの定量が可能である。市販の測定装



図 1 シリカガラス表面の水の存在形態

置もある。

OH 基の存在形態は極めて複雑であるが大ま かに分類して図 1 に示した。まず,孤立した OH 基が近接している場合(I),完全に孤立 した OH 基(Ⅱ),OH 基が近接しているとこ ろに水分子が水素結合している場合(Ⅲ),孤 立した OH 基に水分子が水素結合している場合 (Ⅳ),そして OH 基上に水がクラスター状に水 素結合している場合(V)である。これらは, 赤外領域(4000 cm⁻¹~3000 cm⁻¹)に吸収ピー クを持つがピーク位置の重なりが著しく分離す ることが難しい。もしも,高濃度である場合(例 えば,ドライゲル)には,倍音の波長領域に吸 収が現れ,吸収ピークの帰属ができている。

それらをまとめたものが表である。 v_{s} , v_{as} : 対称,非対象(逆対称)伸縮振動 v_{B} , v_{R} , v_{L} は それぞれ bending, hindered rotation, translational absorption mode を示す。この表は、参 考文献^{2,3)}等を元に筆者が作成したものである。 原著論文にはこの他にピーク分離を行って帰属 した結果も掲載されているが、ピークが見えて いない吸収帯に対して分離するという手法^{2,10)} は議論のあるところであり、本表中には載せて いない。

また、帰属だけでなく、定量に関しての情報 も実用上必要かと思われる。Abe ら²⁴⁾は、赤外 吸収スペクトルにおける各種ガラス中と OH 基 ピーク位置(波数)とモル吸光係数との関係を 一覧表にまとめている。²⁴⁾しかしながら、その 相関関係は弱いことに気づく。シリカガラスの みに限定して、調べてみても大きくばらついて いる。例えば、Shelby らは 181 L/mol・cm²⁵⁾、 Stephenson らは 77.5 L/mol・cm²⁶⁾という値を 出している。

OH 基の導入により、シリカガラス特有の欠 陥構造である平面 3 員環、4 員環構造が減少 することも知られている。²⁷⁾これらの欠陥構造 はラマン分光により、D₁, D₂ ラインと名づけら れた特徴あるシグナルにより容易に検出され る。²⁸⁾これらの欠陥種は活性で、放射線などに よって,開環して常磁性中心に変化する。²⁹⁾また,バンドギャップも6員環を中心とする構造に比べて狭く,光吸収端を長波長側ヘシフトさせる。OH 基は放射線下において,水素結合することも知られている。³⁰⁾

赤外吸収スペクトルにおいては、1100 cm⁻¹ 付近に強い強度で吸収帯(ω_s)が検出される。 これは Si-O 非対称伸縮振動に帰属される³¹⁾。 このピークから Si-O-Si の結合角を計算により 求めることができる。また、OH 基の濃度が高 くなるほど、 ω_s のピーク位置は高波数側にシ フトしていくことも複数の研究者によって報告 されている³²⁾。この ω_s は、膜厚が厚くなるほ ど高波数側にシフトすることも知られており、 s-shift と呼ばれている³³⁾。その理論的解析もな されている³⁴⁾。

3. 最近の OH 基に関するトピックス

最近のシリカガラスの用途として,表面修飾 が取り上げられている。論文も2000年以降に 発表されたものも多く,本誌で紹介するにふさ わしいと思われる。表面修飾において重要なの は表面のOH基である。このOH基に表面修 飾物質を化学結合させることができるためであ る。そこで,表面OH基の最近の研究事例を紹 介したい。

非晶質シリカ表面に一層の OH 基が形成され た場合の H₂O の量は,ポーラスシリカのデー ターによると 7.6 μ mol/m² であることがわか っている。この値は,製法や素性の異なる 10 種類以上にポーラスシリカにおいても,またシ リカガラス (Type IV) においても,ほぼ同一 の値が得られている。もちろん,OH 基の上に 二層,あるいは多層の OH 基,H₂O が水素結 合していくことも考えられる。図 2 は Kromasil を用いた表面吸着水の時間変化を調べた 報告である³⁵⁾。a~f はそれぞれ,湿度 11%,33 %,43%,51%,75%,85%の例である。湿度 11%,33%の雰囲気においては,表面の水は 7.6 μ mol/m² (点線)よりも低い量で飽和して しまう。43%,51%の場合には、ちょうど一層 分に相当する 7.6 μmol/m²で飽和しているこ とがわかる。さらに、湿度 75%の場合 2 層に 相当する~15 μmol/m²で飽和していることが わかる。

シリカガラス中の水は,高温下で脱離することも,赤外吸収スペクトル³²,質量分析³⁶⁾の両面から詳しく調べられている。

10年ほど前より、エキシマランプ等、各種 の紫外線ランプが入手しやすくなった。紫外光 を照射することにより、各種塗布剤がきれいに むらなく塗れるため、利用がガラスのみではな く光触媒等、各分野に広がっている。単純に有 機物による汚れが除去されるため(オゾンアシ ャー)であるとも考えられているが、Shelby らから興味深い報告がなされている³⁰。図3は シリカガラスをO₂、H₂Oプラズマ、及び高湿 度下においての340 nm 紫外光照射により、表 面を改質し、赤外吸収により表面のOH 基を観



図 2 Kromasil への水の吸着。湿度 11 (a), 33 (b), 43
 (c), 51 (d), 75 (e), 85% (f) の場合。平行の破線は、下からそれぞれ 1, 2, 3 層の H₂O が吸着した場合の理論値である。参考文献 35 より引用。

ピーク位置 (cm ⁻¹)	Labels	帰属
7342		図 1 (I) ⁴⁾
7305		図 1 (II) ⁴⁾
7194		図 1 (III) ⁴⁾
6944		図 1 (IV) ⁴⁾
5292		⊠ 1 (III) ⁴)
5179		$\mathbb{E} 1 (\mathrm{IV})^{4}$
5001		図 1 (V) ⁴⁾
4545		図 1 (III) ⁴⁾
4444		⊠ 1 (IV) ⁴⁾
4348		⊠ 1 (V) ⁴⁾
4000, 3920-3980, 3940	$v_{s}(H_{2}O) + v_{R}(H_{2}O) - v_{T}(H_{2}O)$	高濃度の H ₂ O を含有するシリ
± 15		カガラス等に微弱な吸収とし
3846-3850~3850	$\gamma_{s}(SiOH) + \nu_{s}(OH)$	て現れる。 ⁵⁻⁸⁾
3750		孤立した Si-OH 基の伸縮振動
3749		線幅の狭い鋭いピーク ^{9,10)}
3748		隣接する OH 基が水素結合し
		た Si-OH 基の伸縮振動 ^{9), 10)}
3747		孤立した表面の Si-OH ¹¹⁾
3745		水素結合した Si-OH ¹⁰⁾
3744		OH 基の伸縮振動 (隣接してい
		る OH 基で水素結合していな
		いもの) ¹⁰⁾
3720		水素結合したシラノール基 10,11)
3715		OH 伸縮振動 ¹⁰⁾
3673-3670	$v_{s}(OH), v_{s}(H_{2}O)$	SiOH の OH 基の伸縮振動とガ
		ラス中の水の非対称伸縮振動
3600-3610	$\nu_{s}(OH)_{III}$	ガラス中の水分子と水素結合
	$\nu_{s}(OH^{-H}OH)$	した OH 基の伸縮振動 ^{8,12,13)}
~3450	$\nu(H_2O)_{I\&_{II}}$	シリカガラスに結合した水分
3445		子の OH の非対称伸縮振動
~3425		14-17)
3410		水分子 10)
3392-3433	$2 v_{R}(H_2O)$	Hindered rotation の倍音 ^{18,19)}
3410±5	$\nu_{ss}(H_2O)$	水分子の対称伸縮振動 109
3220	$v_{As}(H_2O)$	水分子の非対称伸縮振動 15-17)
~3225	$2\nu_{\mathbf{B}}(\mathrm{H}_{2}\mathrm{O})$	水分子の変角振動(1611cm ⁻¹)
3450		の倍音 ²⁰⁾
2135-2092	$\nu_{\mathbf{B}}(\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}) + \nu_{\mathbf{R}}(\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}) - \nu_{\mathbf{T}}(\mathrm{H}_{2}\mathrm{O})$	結合振動 ²¹⁾
1649-1610	$\nu_{\mathbf{B}}(\mathrm{H}_{2}\mathrm{O})$	水分子の変角振動 ²²⁾
1357	$\nu_{\rm R}({\rm H_2O})$	2)
760-670	$\nu_{R}(H_{2}O)$	23)
500	$\nu_{R}(H_{2}O) - \nu_{T}(H_{2}O)$	結合振動 ²³⁾
185-155	$\nu_{\rm T}({\rm H_2O})$	23)

察したものである。反射スペクトルを Kubelka Munck 変換して表記されている。紫外光照射 効果により表面の OH 基が増大していることが わかる。その後の塗布剤,シランカップリング 剤が良好にコートできるメカニズムを考える上 で重要である。



図 3 各種表面処理によるシリカガラスの赤外吸収 反射スペクトルの変化。UV/H₂O:紫外光(340 nm で^{0.4}W/m²) 照射下かつ高湿度雰囲気下で 90 時間処理。O₂, H₂O プラズマ;プラズマ発生装置 を用いて表面処理を行った。参考文献 37 より引 用。

4.今後の展望

OH 基に関する研究は,1930年代より論文が あるものの,本稿で紹介したとおり複雑に水素 結合するために完全に解明されてはいない。曖 昧さを残しつつ,かなり広い分野で表面 OH 基 を用いた表面修飾,表面反応が盛んに行われ, ガラス材料がバイオや機械工学の研究者にとっ て身近な材料となってきている。今後楽しみで ある。

- 内田直也,上杉直,稲垣伸夫,電子通信学会 誌,68,157 (1985).
- 2) K. M. Devis, M. Tomozawa, J. Non-Cryst. Solids, 201, 177 (1996).
- 3) R. L. DeRosa, P. A. Schader, J. E. Shelby, J. Non-Cryst. Solids, 331, 32 (2003).
- 4) D. L. Wood, E. M. Rabinovich, D. W. Johnson, Jr., J.
 B. MacChesney, E. M. Vogel, J. Am. Ceram.
 Soc., 66, 693 (1983).
- 5) C.-K. Wu, J. Am. Ceram. Soc. 63, 453 (1980).
- 6) J. G. Bayly, V. B Kartha, W. H. Stevens, Infrared

Phys. 3, 211 (1963).

- 7) D. Williams, Nature 210, 194 (1966).
- 8) J. R. Collins, Phys. Rev. 55, 470 (1939).
- 9) C. J. Brinker, G. W. Scherer, Sol-Gel Science, The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing, Academic Press, San Diego, CA, 1990.
- 10) P. Hoffmann, E. Knozinger, Surf. Sci. 188, 181 (1987).
- B. A. Morrow, A. J. McFarlan, J. Non-Cryst. Solids 120, 61 (1990).
- 12) B. A. Morrow, I. A. Cody, L. S. M. Lee, J. Phys. Chem. 80, 2761 (1976).
- 13) G. E. Walrafen, S. R. Samanta, J. Chem. Phys. 69, 493 (1978).
- 14) M. Bredol, D. Leers, L. Bosselaar, M. Hutjens, J. Lightwave Technol 8, 1536 (1990).
- 15) R. D. Aines, G. R. Rossman, J. Geophys. Res. 89, 4059 (1982).
- 16) A. K. Kronenber, G. H. Wolf, Tectonophysics, 172, 255 (1990).
- 17) S. Nakashima, S. Ohki, S. Ochiai, Geochem. J. 23, 57 (1989).
- 18) F. M. Ernsberger, J. Am. Ceram. Soc. 60, 91 (1977).
- 19) G. E. Walrafen, J. Chem. Phys. 40, 3249 (1964).
- 20) J. W. Ellis, B. W. Sorge, J. Chem. Phys. 2,559 (1934).
- 21) H-H. Park, M. -H. Jo, H. -R. Kim, S. -H. Hyun, J. Mater. Sci. Lett. 17, 2083 (1998).
- 22) P. F. McMillan, R. L. Remmele, Am. Mineral, 71, 772 (1986).
- 23) D. A. Draegert, N. W. B. Stone, B. Curnutte, D. Williams, J. Opt. Soc. Am., 56, 64 (1966).
- 24) Y. Abe, D. E. Clark, J. Mat. Sci. Lett., 9,244 (1990).
- 25) J. E. Shelby, J. Am. Ceram. Soc., 65, C 59 (1982).
- 26) G. Stephenson and K. H. Jack, Tran. Br. Ceram. Soc., 59, 397 (1960).
- 27) A.E. Geissberger, F.L. Galeener, Phys. Rev. B 28, 3266 (1983).
- 28) J. B. Betes, R. W. Hendricks, L. B. Shaffer, J. Chem. Phys., 61, 4163 (1974).
- 29) F. L. Galeener, D. B. Kerwin, A. J. Miller, J. C. Mikkelsen, Jr., Phys. Rev. B 47, 7760 (1993).
- 30) J. E. Shelby, J. Non-Cryst. Solids, 179, 139 (1994).
- 31) K. Awazu, H. Kawazoe, J. Appl. Phys., 94, 6243 (2003).
- 32) M. Nakamura, R. Kanazawa, K. Sakai, J. Electrochem. Soc., 133, 1167 (1986).
- 33) R. Ossokovski, B. Drevillon, M. Firon, J. Opt. Soc. Am., 12, 1797 (1995).
- 34) M. K. Gunde, Appl. Spectrosc., 46, 365 (1992).
- 35) K. E. Collins, V. R. Camargo, A. B. Dimiras, D. T. C.

Menezes, P. A. Silva, C. H. Collins, J. Colloids & Interface Sci., 291, 353 (2005).

36) Y. Morimoto, T. Igarashi, H. Sugawara, S. Nasu, J.

Non-Cryst. Solids, 139, 35 (1992).

37) R. L. DeRosa, P. A. Schader, J. E. Shelby, J. Non-Cryst. Solids, 331, 32 (2003).

NGF ホームページのご案内

(社)ニューガラスフォーラムでは下記のホームページを開設しております。

http://www.ngf.or.jp

是非一度アクセスしてください。

- 1. NGFの開催する各種研究会・研修会のご案内が出ています。
- 2. 機関誌「NEW GLASS」の目次及び2年以前は内容がダウンロードできます。
- 3.「ガラス用語集」「ガラス物性測定方法集」等も纏められています。
- 4. NGFの定款・組織・会員等が「事務局だより」にあります。
- 5. 関連の学会・行事等をお知らせするイベントカレンダーが新設されました。